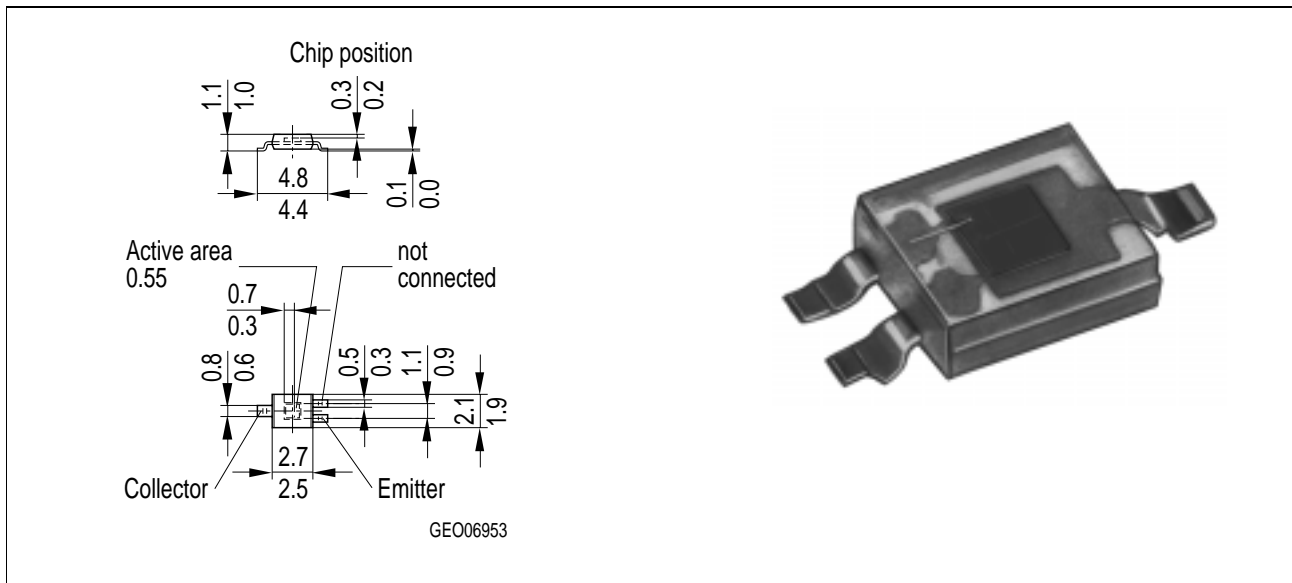


## NPN-Silizium-Fototransistor Silicon NPN Phototransistor

SFH 3400



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

### Wesentliche Merkmale

- Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von 460 nm bis 1080 nm
- Hohe Linearität
- SMT-Bauform ohne Basisanschluß, geeignet für Vapor Phase-Löten und IR-Reflow-Löten (JEDEC level 4)
- Nur gegurtet lieferbar

### Anwendungen

- Umgebungslicht-Detektor
- Lichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb
- Industrieelektronik
- „Messen/Steuern/Regeln“

### Features

- Especially suitable for applications from 460 nm to 1080 nm
- High linearity
- SMT package without base connection, suitable for vapor phase and IR reflow soldering (JEDEC level 4)
- Available only on tape and reel

### Applications

- Ambient light detector
- Photointerrupters
- Industrial electronics
- For control and drive circuits

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code	Gehäuse Package
SFH 3400	Q62702-P1796	Klares Epoxy-Gießharz, Kollektorkennzeichnung: breiter Anschluß
SFH 3400-2	Q62702-P1103	
SFH 3400-3	Q62702-P1805	Transparent epoxy resin, collector marking: broad lead

## Grenzwerte Maximum Ratings

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}; T_{stg}$	- 40 ... + 85	°C
Kollektor-Emitterspannung Collector-emitter voltage	$V_{CE}$	20	V
Kollektor-Emitterspannung, $t < 120$ s Collector-emitter voltage	$V_{CE}$	70	V
Kollektorstrom Collector current	$I_C$	50	mA
Kollektorspitzenstrom, $\tau < 10$ $\mu$ s Collector surge current	$I_{CS}$	100	mA
Emitter-Kollektorspannung Emitter-collector voltage	$V_{EC}$	7	V
Verlustleistung, $T_A = 25$ °C Total power dissipation	$P_{tot}$	120	mW
Wärmewiderstand für Montage auf PC-Board Thermal resistance for mounting on pcb	$R_{thJA}$	450	K/W

**Kennwerte** ( $T_A = 25\text{ °C}$ ,  $\lambda = 950\text{ nm}$ )

**Characteristics**

<b>Bezeichnung</b> <b>Description</b>	<b>Symbol</b> <b>Symbol</b>	<b>Wert</b> <b>Value</b>	<b>Einheit</b> <b>Unit</b>
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity	$\lambda_{S\text{ max}}$	850	nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit $S = 10\%$ von $S_{\text{max}}$ Spectral range of sensitivity $S = 10\%$ of $S_{\text{max}}$	$\lambda$	460 ... 1080	nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche Radiant sensitive area	$A$	0.55	mm <sup>2</sup>
Abmessung der Chipfläche Dimensions of chip area	$L \times B$ $L \times W$	1 x 1	mm x mm
Abstand Chipoberfläche zu Gehäuseoberfläche Distance chip front to case surface	$H$	0.2 ... 0.3	mm
Halbwinkel Half angle	$\varphi$	$\pm 60$	Grad deg.
Kapazität, $V_{\text{CE}} = 0\text{ V}$ , $f = 1\text{ MHz}$ , $E = 0$ Capacitance	$C_{\text{CE}}$	15	pF
Dunkelstrom Dark current $V_{\text{CE}} = 10\text{ V}$ , $E = 0$	$I_{\text{CEO}}$	10 ( $\leq 200$ )	nA

Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet.

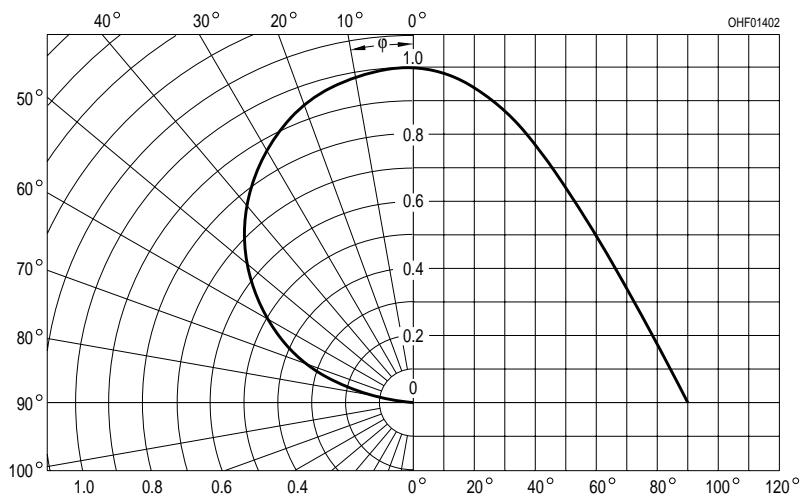
The phototransistors are grouped according to their spectral sensitivity and distinguished by arabian figures.

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value			Einheit Unit
		-1	-2	-3	
Fotostrom, $\lambda = 950 \text{ nm}$ Photocurrent $E_e = 0.1 \text{ mW/cm}^2$ , $V_{CE} = 5 \text{ V}$ $E_v = 1000 \text{ lx}$ , Normlicht/standard light A, $V_{CE} = 5 \text{ V}$	$I_{PCE}$	63 ... 125	100 ... 200	160 ... 320	$\mu\text{A}$
	$I_{PCE}$	1.65	2.6	4.2	$\text{mA}$
Anstiegszeit/Abfallzeit Rise and fall time $I_C = 1 \text{ mA}$ , $V_{CC} = 5 \text{ V}$ , $R_L = 1 \text{ k}\Omega$	$t_r, t_f$	16	24	34	$\mu\text{s}$
Kollektor-Emitter- Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage $I_C = I_{PCEmin}^{1)} \times 0.3$ , $E_e = 0.1 \text{ mW/cm}^2$	$V_{CEsat}$	170	170	170	$\text{mV}$

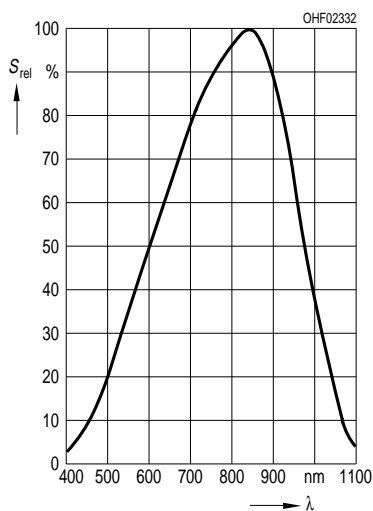
1)  $I_{PCEmin}$  ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe

1)  $I_{PCEmin}$  is the min. photocurrent of the specified group

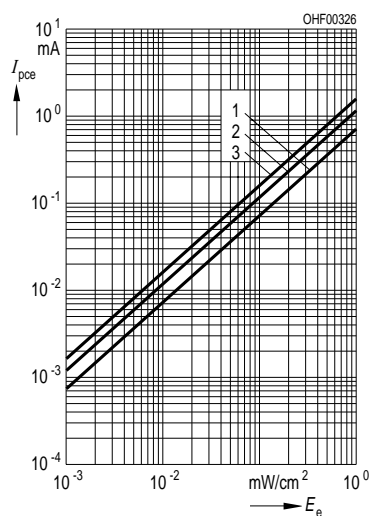
Directional characteristics  $S_{rel} = f(\varphi)$



$T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$ ,  $\lambda = 950\text{ nm}$   
 Rel. spectral sensitivity  $S_{rel} = f(\lambda)$

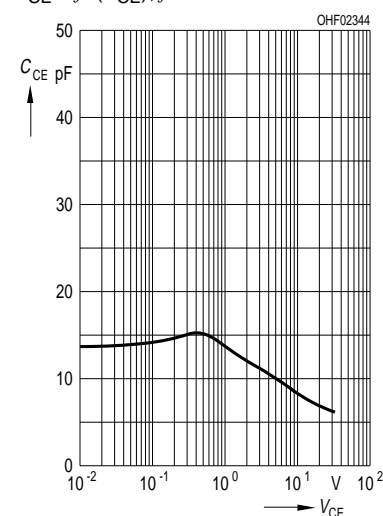


Photocurrent  $I_{PCE} = f(E_e)$ ,  $V_{CE} = 5\text{ V}$

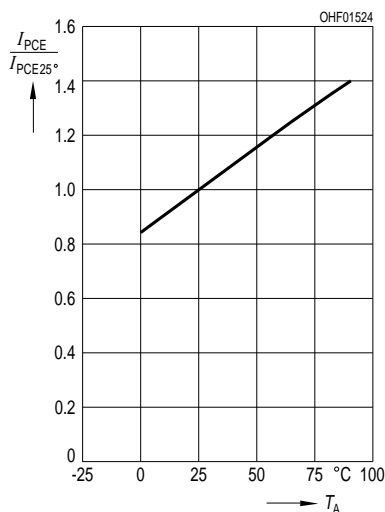


Collector-emitter capacitance

$C_{CE} = f(V_{CE})$ ,  $f = 1\text{ MHz}$

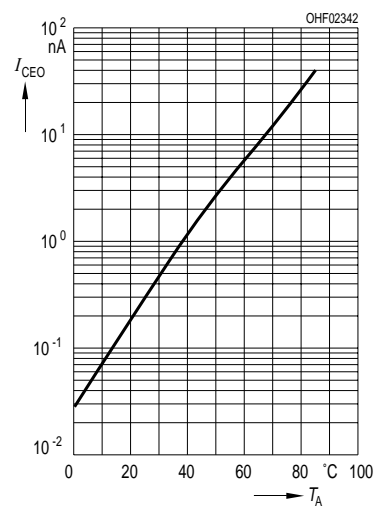


Photocurrent  $I_{PCE} = f(T_A)$ ,  
 $V_{CE} = 5\text{ V}$ , normalized to  $25\text{ }^\circ\text{C}$



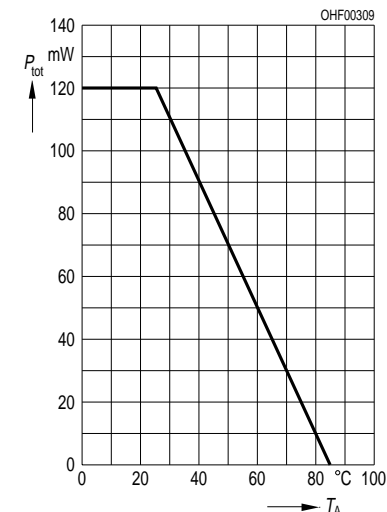
Dark current

$I_{CEO} = f(T_A)$ ,  $V_{CE} = 10\text{ V}$ ,  $E = 0$

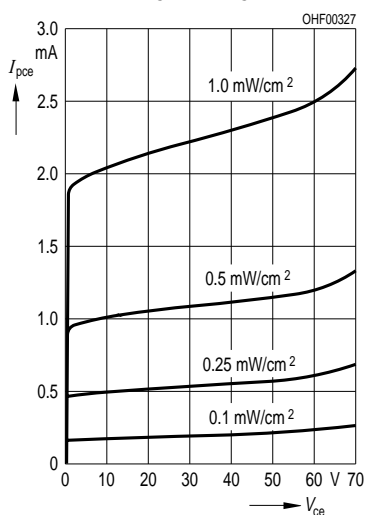


Total power dissipation

$P_{tot} = f(T_A)$



Photocurrent  $I_{PCE} = f(V_{CE})$



Dark current  $I_{CEO} = f(V_{CE})$ ,  $E = 0$

